

Lundi 01/07	
13h30-14h00	Accueil
14h00-14h30	Présentations des sponsors
Axe 1 : Modélisation et couplage entre théorie et expérience	
Pierre Müller, Olivier Pierre-Louis, Laurent Pizzagalli	
	Chairman: Pierre Müller
14h30-15h00	Invité: Salvalaglio Marco - Crystal growth and morphological evolution of thin films by phase field modeling
15h00-15h20	Guillaume Monier - Study of plasma nitridation process for GaAs surface passivation
15h20-15h40	Francesco Boccardo - Coupling of solid-state dewetting with the ATG instability
15h40-16h10	Invité: Olivier Pierre-Louis - Formation of rough grain boundaries in 2D materials
16h10-16h30	Pause Café
Axe 2 : Intégration monolithique hétérogène et hétéroépitaxie sur silicium	
Yvon Cordier, Charles Cornet, Guillaume Saint-Girons	
	Chairman: Yvon Cordier
16h30-17h00	Invité: Charles Cornet - Universal growth mechanism of III-V/Si: using antiphase boundaries for devices.
17h00-17h20	Marie-Léonor Touraton - III-As and III-P semiconductor thin layers directly integrated via MOCVD selective area epitaxy for optical emission on 300 mm Si (001)
17h20-17h40	Oumaima Abouzaid - MOCVD grown InAs/GaAs quantum dots on GaAs and Ge/Si substrates
17h40-18h00	Benjamin Damilano - Fabrication de nanostructures de GaN par un procédé de sublimation sélective
18h00-18h30	Invité: Clément Merckling - Molecular beam epitaxy of 2D Selenides
Mardi 02/07	
Axe 3 : Organisation sur substrat fonctionnalisé et nanostructuré, croissance sélective et épitaxie latérale	
Yamina André, Ludovic Desplanque, Xavier Wallart	
	Chairman: Xavier Wallart
9h00-9h30	Invité: Heinz Schmid - Selective epitaxy for device integration and novel material synthesis
9h30-9h50	Roy Dagher - Nano-patterned SOI substrates as a platform for epitaxial growth of highly mismatched epilayers: the case of nitride compounds
9h50-10h10	Mohammed Zeghouane - Selective growth of In(Ga)N nanowires by HVPE
10h10-10h40	Invité: Philippe Caroff - Selective Area Epitaxy of Superconductor/Semiconductor heterostructures
10h40-11h00	Pause café
Axe 4 : Caractérisations ultimes : locales, microscopiques et globales	
Patrick Le Fevre, Gilles Renaud, Philippe Venegues	
	Chairman: Philippe Venegues
11h30-12h00	Invité: Stéphane Andrieu - Alliages d'Heusler épitaxiés : matériaux d'avenir en spintronique
12h00-12h20	Clara Cornille - Comparative study of GaAs and GaAsBi grown at low temperature by molecular beam epitaxy
12h20-14h00	Pause Déjeuner
14h00-14h20	Frédéric Leroy - In operando microscopy studies of electromigration and thermomigration of Si islands on Si(100) and Si(111)
14h20-14h50	Invité: Bastien Bonafant - Nanometer scale quantification of alloy fluctuations in epitaxially grown ternary nitride based devices
14h50-16h30	Pause Café et présentation des posters
	Animatrice : Isabelle Berbezier
16h30-18h00	Table Ronde : ouverture du GDR à l'Europe
18h00-19h00	Réunion du comité national du GDR
Mercredi 03/07	
Axe 5 : Nouvelles techniques instrumentales liées à l'épitaxie et nouveaux systèmes	
Alexandre Arnoult, Paola Atkinson, Antoine Ronda	
	Chairman: Paola Atkinson
9h00-9h30	Invité: Wolfgang Braun - Epitaxy at Ultrahigh Temperatures
9h30-10h00	Invité: Mark Hopkinson - In-situ laser interference lithography for the patterning of MBE growth surfaces
10h00-10h20	Stéphane Andrieu - Le TUBE-Damv : 70 mètres sous UltraVide
10h20-10h40	Pause café
Axe 6 : Propriétés (optiques, électroniques, etc.) des systèmes épitaxiés et applications	
Michèle Amato, Hélène Carrere, Noëlle Gogneau	
	Chairman: Noëlle Gogneau
10h40-11h10	Invité: Gustavo Ardila - Modeling of Semi-Conducting Piezoelectric Devices: The influence of Free Carriers and Surface Traps
11h10-11h30	Léo Mallet-Dida - Spectroscopie de nanofils p-i-n élaborés par MOCVD
11h30-11h50	Guillaume Saint-Girons - (La,Sr)TiO3/SrTiO3 superlattices as hyperbolic metamaterials
11h50-12h20	Invitée: Sophie Meuret - Time-resolved cathodoluminescence spectroscopies for semiconductors
12h20-13h30	Pause Déjeuner
13h30-19h00	Excursion Puy de Dôme
20h00	Dîner de la conférence
Jeudi 04/07	
Axe 7 : Nouveaux matériaux semiconducteurs (oxydes, organiques) et nouveaux systèmes 2D	
Mathieu Jamet, Holger Vach, Dominique Vignaud	
	Chairman: Clément Merckling
9h00-9h30	Invité: Thomas Pierron - Caractérisation par photoémission X et UV d'une monocouche de Germanatène/Silicatène sur Ru(0001)
9h30-9h50	Philippe Venneguès - Al ₅ +αSi ₅ +δN ₁₂ , a new Nitride semiconductor
9h50-10h10	Hamza Khelidj - Growth of GeSn thin films by magnetron sputtering
10h10-10h30	Mama Bouchaour - Characterization of Zinc oxide thermal evaporated thin films
10h30-11h00	Jawad Hadid - Molecular beam epitaxial growth of hexagonal boron nitride on Ni substrates
11h00-11h30	Pause café
Axe 8 : Nanofils	
Sébastien Plissard, Vincent Sallet, Vincent Consonni	
	Chairman: Sébastien Plissard
11h30-12h00	Invité: Lucia Sorba - Growth dynamics of InAs/InP nanowire heterostructures by Au-assisted chemical beam epitaxy
12h00-12h20	Jose Penuelas - Ingénierie de la phase cristalline de nanofils de GaAs élaborés par épitaxie par jets moléculaires
12h20-13h30	Pause Déjeuner
	Chairman: Vincent Consonni
13h30-13h50	Laetitia Vincent - In-situ TEM observation of epitaxial growth of core/shell GaAs/Ge nanowires
13h50-14h10	Camille Barbier - Etude in situ de la nucléation du GaN sur graphène transféré par diffraction des rayons X
14h10-14h30	Vincent Grenier - MOVPE GaN Wires with m-plane Core-Shell GaN/AlGaIn MQWs for UV Emission
14h30-15h00	Invité: Sergio Fernandez-Garrido - Molecular Beam Epitaxy of GaN Nanowires on Nonconventional Substrates
15h00-16h00	Clôture de la Conférence